

Procedeu de obținere a lentilelor în baza semiconductoarelor cu gradient al indicelui de refracție, caracterizat prin aceea că într-un substrat de semiconductor se implantează ioni la o doză de energie înaltă, determinată de relația

$$D = \alpha R^2,$$

unde:

D – doza energiei înalte a ionilor implantați,

R – distanța de la centru până la periferia stratului,

α – gradientul dozei,

apoi se efectuează decaparea electrochimică.